ООО "НПП ТЭЗ"
140070, РФ, Московская обл.
Люберецкий р-н пос. Томилино
ул. Гаршина, д. 11

Микросхемы интегральные
ОСМ14.2ЕП1

ОСМ14.2ЕП1 - 6331000009

ЭТИКЕТКА

ТР3.439.000-02 ЭТ

Микросхемы интегральные ОСМ14.2 ЕП1 в металлокерамическом корпусе 4.112.16-15.01 предназначены для использования в качестве схемы управления импульсного стабилизатора напряжения

Категория качества "ОСМ".

СЕРТИФИКАТ № СВС.04.431.0296.11 от 25 апреля 2011г.
действителен до 25 апреля 2014г. Выдан "ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ"
на соответствие требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 (в части ЭКБ)
и РД В 319.015-2006.

Маркировка микросхем кодовая:
ОСМ14.2ЕП1 - ОСМ26
Дата изготовления кодируется по ГОСТ 30668-2000.
Содержание маркировки - год, неделя.

Схема расположения выводов

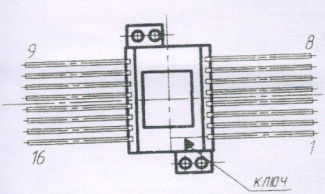
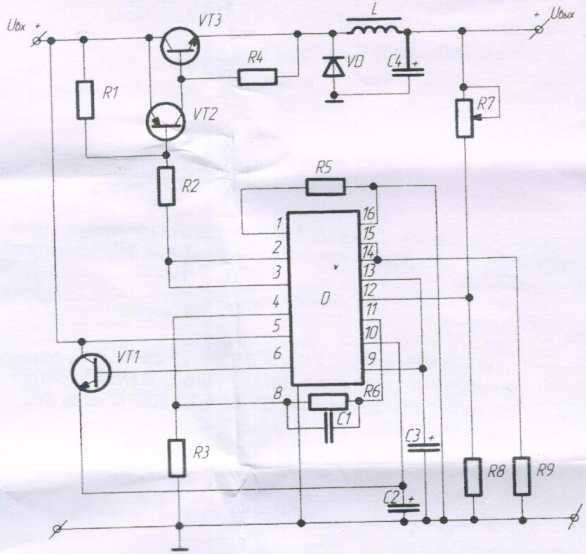


Таблица назначения выводов

Номер вывода	Назначение вывода	Номер вывода	Назначения вывода
1	База	9	Опорное напряжение
2	Коллектор	10	Питание
3	Коллектор	11	Выход порогового устройства
4	База	12,13	Вход управления
5	Питание	14,15	Вход синхронизации
6	Эмиттер	16	Эмиттер
7	База		
8	Общий		

Основная электрическая схема включения микросхемы.



VT1 – транзистор 2Т630А или аналогичный;

D – микросхема;

VT2–р–п–р – транзистор с коллекторным током, достаточным для управления транзистором VT3, работающим в режиме переключения тока.. Время рассасывания и нарастания не более 0.2мкс.

VT3 – транзистор 2Т903 или аналогичный;

VD – диод 2Д213;

L – дроссель Д233Т;

C1 – конденсатор 100–1000 пФ;

C2, C3 – конденсаторы 5 мкФ;

C4 – конденсатор 200 мкФ;

R1=200 Ом R6=3 кОм

R2=1 кОм R7=33 кОм

R3=10 кОм R8=1,5 кОм

R4=56 Ом R9=100 кОм

R5=300 Ом

R6=3 кОм

R7=33 кОм

R8=1,5 кОм

R9=100 кОм

Примечание. Допускается включение резисторов между выводами 14, 15 и 8 номиналом 200 кОм в случае использования выводов 14 и 15 для внешней синхронизации и других схемотехнических решений.

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры (tокр.ср=(25±10)°С)

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Норма	
	не менее	не более
Опорное напряжение, В при Uп1= 4.0 В, Uп1=10 В	1,7	2,2
Остаточное напряжение, В при I вых=50...200 мА, U п1=10...40 В		1,8
Напряжение гистерезиса, мВ при I вых =50мА, Uп1 =10...40 В, Uп2 =5...7 В, U ком.вх=10...40 В		5
Ток закрытой микросхемы, мкА при U ком.вх=10...40 В, U п1 =10...40 В		100

1.2 Содержание драгоценных металлов в одной микросхеме:

Золото – 20,4993 мг, серебро – 27,5719 мг.

в том числе расчетное нормативное содержание золота одного погонного мм 16 выводов – 0,6052 мг.

1.3 Цветных металлов не содержится.

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Минимальная наработка микросхем в режимах и условиях, установленных в ТУ – 150 000ч.

2.2 Минимальный срок сохраняемости – 25 лет.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данных микросхем требованиям ЖКО.347.098 ТУ2, ПО 070.052 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в ТУ.

Гарантийный срок 25 лет с даты изготовления.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 0СМ142 ЕП1 соответствуют техническим условиям бК0.347.098 ТУ2. ПО 070.052 и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по Акт 3 от 23.07.12г
указывают документ о приемке (извещение, акт и др.) дата

Место для штампа СККП — ОТК 6 № 88 — подпись лица, ответственного за приемку — Место для штампа ВП

Место для штампа — Перепроверка произведена 8.10.13г
дата

Приняты по Акт 3 от 23.07.12г
указывают документ о приемке (извещение, акт и др.)

Место для штампа СККП — ВТК 6 № 29 — подпись лица, ответственного за приемку — Место для штампа ВП

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Указания по применению и эксплуатации по ОСТ В 11 0492-87 с дополнениями, изложенными в соответствующем разделе бК0.347.098ТУ2. Допустимое значение статического потенциала 100 В.

28 ИЮН 2012

УПАКОВЩИЦА № 70

08 ОКТ 2013

УПАКОВЩИЦА № 70